

ECMP

JESINE
洁芯半导体
JESINE SEMICONDUCTOR

NEW Electro-Chemical Mechanical Polishing

新型电化学机械抛光设备 NEW-ECMP



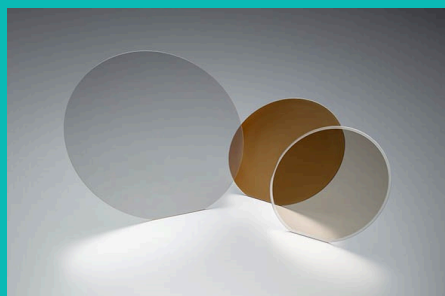
难削材高速度抛光

废液减少提升环保

第三代半导体抛光设备



SiC

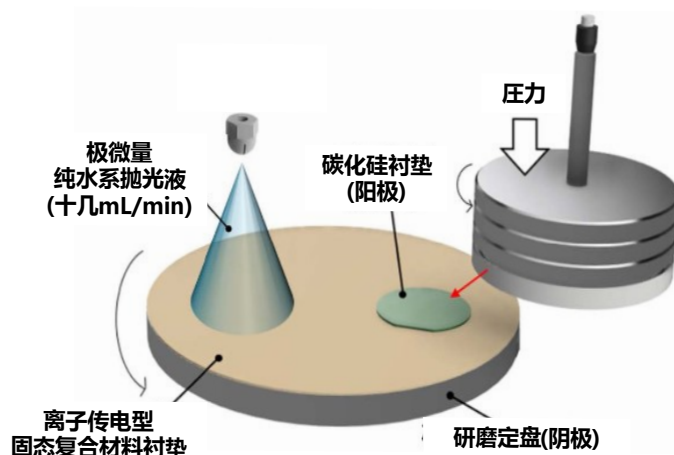


GaN

加工平台



加工原理



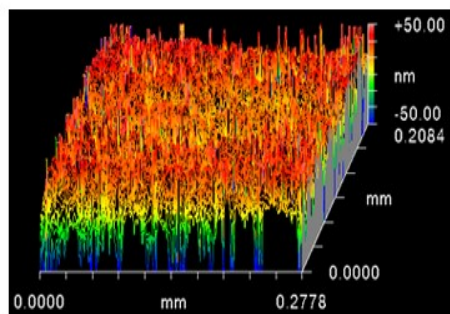
加工案例

碳化硅 (4H-N SiC)

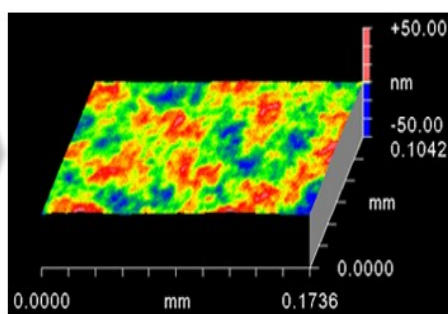
尺寸 : 4英寸 (100mm) , 厚度350 μ m

加工表面 : Si面

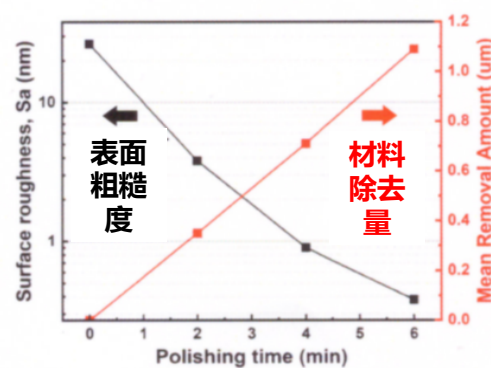
加工时间 : 6分钟



加工前表面粗糙度
Sa; 26.4nm



加工后表面粗糙度
Sa; 0.38nm



材料出去率
MRR; 10.5 μ m/Hr以上

